

NANOBITM

Polishing slurry for SiC wafers



製品概要

Product summary

◎MnO₂砥粒により高レート・ダメージフリーな加工が可能

High-rate, damage-free polishing with MnO₂ abrasive.

◎C面とSi面を同レートで加工可能

C and Si surfaces can be polished at the same rate.

◎砥粒が完全溶解するため装置洗浄/ウェハ洗浄が容易

Easy cleaning of equipment and wafers with Soluble abrasive.

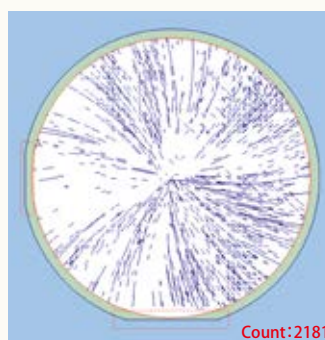
製品外観/加工例

Product appearance / Processing examples

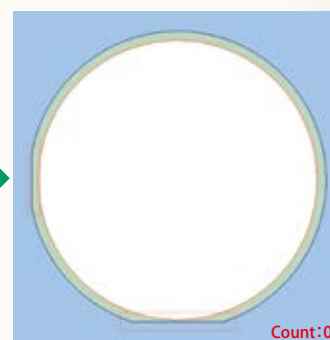


A液

B液



◆ 研摩前 (Ra 41.9nm) ◆

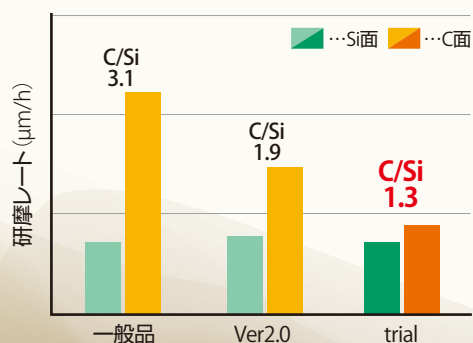


◆ 研摩後 (Ra 0.14nm) ◆

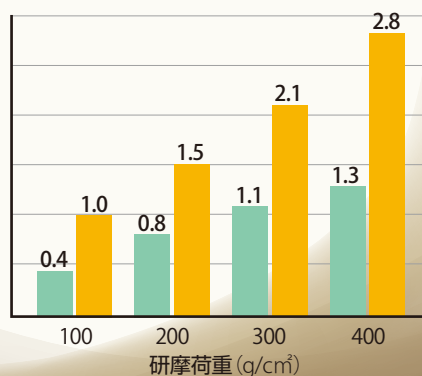
製品データ (代表値)

Product data

[研摩面のレート比]



[荷重依存性]



[研摩条件]

パッド	SUBA600
流量	200ml/min
回転	60rpm
荷重	200g/cm ²